

Projet de Fin d'Études
Master Sciences et Techniques

Option : Génie Énergétique

Titre :

Estimation des paramètres des cellules photovoltaïques

Présenté par :

Youssef Kharchouf

Date de soutenance : Juin 2020

Devant le Jury :

<i>Nom et Prénom</i>	<i>Établissement</i>	<i>Qualité</i>
		<i>Président</i>
		<i>Examineur</i>
		<i>Encadrant Externe</i>
Dr. Adil Chahboun	FST de Tanger	<i>Encadrant de la FST</i>

PFE effectué au :

(Laboratoire ou Société ou Organisme)

LOGO du Laboratoire ou de la Société ou de l'organisme,

Résumé

Les cellules solaires photovoltaïques sont généralement modélisées avec un circuit électrique comprenant un certain nombre de paramètres.

Abstract

Solar PV cells are generally represented by a lumped-element model with a set number of components which are represented by their parameters. These parameters are not readily available in manufacturer data-sheets despite being crucial to the accuracy of the model. A possible approach is to estimate these parameters using the Current-Voltage characteristic of a cell using numerical or analytic techniques. Metaheuristics such as Differential Evolution take the approach of an optimization with the objective function to be minimized being the error with experimental Current-Voltage data. This work is a comparative analysis between different combinations of methods such as Differential Evolution and Particle Swarm Optimization applied to the single and double diode models for various solar cell technologies. PSO is used to initially cover the entire multidimensional search space in order to find a region with global minimum, which is subsequently given to the DE algorithm in order to locate the solution with the best fitness within this region. A small tool implementing these methods has been developed using the Python programming language.

Nomenclature

CR	Taux de croisement	
D	Dimensions de l'espace de recherche	
E_g	Énergie de gap	eV
F	Facteur de mutation	
I_0	Courant de Saturation	μA
I_D	Courant de la diode	A
I_{PV}	Photocourant	A
N_P	Taille de la population	
R_p	Résistance shunt	Ω
R_s	Résistance série	Ω
a	Facteur d'idéalité	
k	Constante de Boltzmann	$1.3806503 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
q	Charge Élémentaire	$1.6021764 \times 10^{-19} \text{ C}$
T	Température de la cellule/du module	K
\vec{V}_{base}	Vecteur de base	
\vec{T}_i	Vecteur d'essai	
\vec{M}_i	Vecteur mutant	
V_t	Voltage Thermique	V
ABC	Colonies d'abeilles artificielles (<i>Artificial Bee Colony Optimization</i>)	
CIABC	Chaotic Improved Artificial Bee Colony	
CWOA	Chaotic Whale Optimization Algorithm	
ED	Évolution Differentielle (<i>Differential Evolution</i>)	
ED3P	Évolution différentielle à trois points	
ELPSO	Enhanced Leader Particle Swarm Optimization	
GA	Algorithme Génétique	
GSA	Gravitational Search Algorithm	
PSO	Optimisation par Essaims Particulaires (<i>Particle Swarm Optimization</i>)	
RMSE	Racine de l'erreur quadratique moyenne (<i>Root Mean Squared Error</i>)	
SA	Recuit Simulé (<i>Simulated Annealing</i>)	
SQ	Formalisme Shockely-Queisser	

Table des matières

Introduction Générale	7
1 Modèles à circuits électriques pour les cellules PV	11
1.1 Introduction	11
1.2 Généralités	11
1.3 Les modèles simple diode R_s et R_p	12
1.4 Modèle double diode	13
1.5 Influence des paramètres des modèles	13
1.6 État de l'art d'estimation des paramètres	15
1.7 Conclusion	15
2 Évolution Différentielle	17
2.1 Introduction	17
2.2 Description de l'algorithme	18
2.2.1 Initialisation	18
2.2.2 Mutation	19
2.2.3 Croisement	19
2.2.4 Sélection	19
2.3 Remarques	20
2.4 Conclusion	20
3 Évolution Différentielle sur les circuits simple et double diodes	23
3.1 Introduction	23
3.2 Fonction W de Lambert	23
3.2.1 Définition	24
3.2.2 Évaluation de la fonction W	24
3.2.3 Résolution des modèles simple et double diode par la fonction W	25
3.3 Résultats	25
3.3.1 Configuration de l'Évolution Différentielle	25
3.4 Utilisation de l'outil <i>DEPV</i>	25
3.5 Conclusion	28
4 Résultats et analyse	29
4.1 Cas 1 : Cellule 57-mm de RTC France	29
4.2 Cas 2 : Module monocristallin Schutten Solar STM6-40/36	30
4.3 Cas 3 : Module polycristallin Photowatt-PWP 201	32
4.4 Analyse et cohérence de l'ED	32

Introduction Générale

L'épuisement des énergies fossiles et leur nature non-durable a conduit à la croissance rapide des énergies renouvelables comme sources alternatives d'énergie. L'énergie solaire est l'une de ces sources renouvelables les plus répandues et a prouvé son utilité dans plusieurs domaines d'applications grâce à sa nature quasiment inépuisable. Les technologies photovoltaïques en particulier ont fait l'objet intense d'étude de la part de la communauté scientifique depuis la première cellule en silicone cristallin à 6 % de Chapin et al. [1] en 1954. Ceci a entraîné une croissance considérable de l'industrie photovoltaïque. En fait, la capacité de production en PV a dépassé les 150GW [2] en 2019 (figure 1), ce qui correspond une croissance d'environ 100GW depuis 2014. Les décennies de recherche depuis la cellule de Chapin et al. visent généralement l'amélioration des cellules solaires (*i*) en explorant les différentes architectures possibles des cellules, (*ii*) en développant des matériaux qui permettent d'augmenter l'efficacité de conversion de l'énergie solaire incidente ou (*iii*) en réduisant le coût du processus de production. La première génération des technologies PV se basait sur des wafer de Silicone comme matériau actif de conversion. La deuxième génération remplace le silicone avec des semi-conducteurs à couches minces, qui, parmi d'autres avantages, réduit considérablement les besoins en matières premières (silicone). Les troisièmes et futures générations comprennent les cellules organiques, Perovskite et les Quantum Dots et présentent des pistes d'investigations pour réduire davantage les coûts de production et augmenter l'efficacité de conversion.

Le principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques a été discuté en profondeur dans la littérature [3, 4, 5]. Les photons à énergie supérieure au bandgap du matériau semi-conducteur sont absorbés en transférant leur énergie aux électrons dans la bande de valence, ce qui leur permet de passer vers la bande de conduction en laissant un "trou" derrière. Le rôle du champ électrique présent dans la zone de déplétion des jonctions P-N est de séparer ces paires électron-trou et leur permettre de circuler à travers une charge extérieure. Toutefois, il y aurait toujours un plafond sur ce mécanisme de conversion "lumière \rightarrow électricité" pour les cellules mono-jonction selon la limite Shockley-Queisser (SQ) [6]. Le modèle SQ postule que tous les photons à énergie supérieure au gap E_g sont absorbés et que la totalité des recombinaisons qui surviennent sont strictement l'inverse du processus d'absorption, c'est-à-dire des recombinaisons radiatives qui réémettent des photons.

Cependant, la performance d'une cellule réelle sera toujours inférieure à la limite SQ (figure 2). Les mécanismes idéaux postulés par le formalisme de SQ sont affectés dans la pratique par plusieurs phénomènes imprévus qui parviennent des propriétés des matériaux utilisés. À titre d'exemple, la présence des défauts dans un semi-conducteur entraîne des recombinaisons non-radiatives où l'énergie des électrons est libérée en phonons dans la structure cristalline et non pas en photon, ainsi que la recombinaison Auger où un autre électron reçoit cette énergie. Les difficultés qui limitent les technologies PV nécessitent une meilleure compréhension des phénomènes physiques complexes impliqués, et l'étude de la performance des cellules par rapport au modèle SQ donne des indices sur la nature des gains en performance qu'une technologie particulière a le potentiel de réaliser.

La modélisation des cellules solaires est s'avère nécessaire par conséquent. Elle est essentielle pour la conception, l'analyse et l'estimation de la performance des cellules solaires. Elle permet d'effectuer l'analyse des propriétés électriques pendant leur phase de développement, l'émulation des systèmes PV pour la prédiction des rendements énergétiques [7], le contrôle de qualité des cellules en phase de production et l'étude des effets de dégradation pendant la phase d'opération [8, 9]. Bien qu'il y a des méthodes de simulations des phénomènes physiques dans la cellule comme celles qui reposent sur la dynamique moléculaire, la théorie fonctionnelle de la densité ou tout simplement des méthodes

numériques appliquées aux équations des semi-conducteurs (équation de Poisson et équations de continuité), etc. Dans ce travail nous nous intéressons à l'approche des circuits équivalents à éléments localisés qui modélisent le comportement I-V de la cellule.

La modélisation d'éléments localisés permet de décrire le comportement des systèmes physiques dispersés spatialement avec un ensemble d'éléments localisés dont chacun représente un phénomène physique particulier. L'analogie électrique dans les problèmes de transferts de chaleur est un exemple de cette méthode où une résistance localisée dans le modèle pourrait représenter la résistance thermique spatialement distribuée selon l'épaisseur de la paroi concernée. Dans le cas des cellules PV, chaque élément du circuit équivalent représente aussi un phénomène physique spécifique dans la cellule (e.g. une résistance en série modélise les pertes ohmiques causées par la résistance intrinsèque au semi-conducteur utilisé). Puisque la caractéristique I-V dépend entièrement des paramètres associés aux éléments localisés du circuit. Il s'agirait donc d'essayer de minimiser l'erreur entre la courbe caractéristique du modèle et celle de la cellule réelle en jouant sur les valeurs des paramètres. Pour ce faire, il existe deux approches principales. La première est l'approche analytique. Elle consiste à utiliser les données sur les points clés de la courbe caractéristique (tension circuit ouvert, courant court-circuit, la pente de la courbe en ces points, ou encore le point de puissance maximale etc) et à effectuer certaines simplifications pour concevoir des formules approximatives, mais rapide à calculer. Toutefois, les simplifications effectuées peuvent conduire à des résultats imprécis ou non physiques (e.g. résistance négative). De plus, le fait que cette approche utilise les données des quelques points seulement la rend vulnérable au bruit de mesures. La deuxième approche est l'extraction numérique. On se retrouve avec un problème d'optimisation, dont la fonction objectif à extrémiser (minimiser) est l'erreur entre le modèle et la courbe expérimentale de la cellule réelle. L'algorithme utilisé pour l'optimisation en soi pourrait être déterministe comme dans le cas des méthodes de Newton-Raphson, Levenberg–Marquardt etc. ou des algorithmes stochastiques/métaheuristique tel que les techniques évolutionnaires. Ces dernières comprennent l'algorithme génétique (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Recuit Simulé (SA) etc. Les méthodes déterministes imposent généralement des critères de convexité, différentiabilité (et par conséquent continuité) de la fonction objectif. Bien qu'elles soient efficaces en terme d'optimisation locale avec des données de gradient, elles sont très susceptibles à se piéger dans des extremums locaux, ce qui limite leurs capacités d'optimisation globale. Par contre les métaheuristiques n'ont pas d'exigences sur la fonction objectif, et le choix des conditions initiales appropriées les rends plus robuste envers les pièges d'extremums locaux.

Dans ce travail..

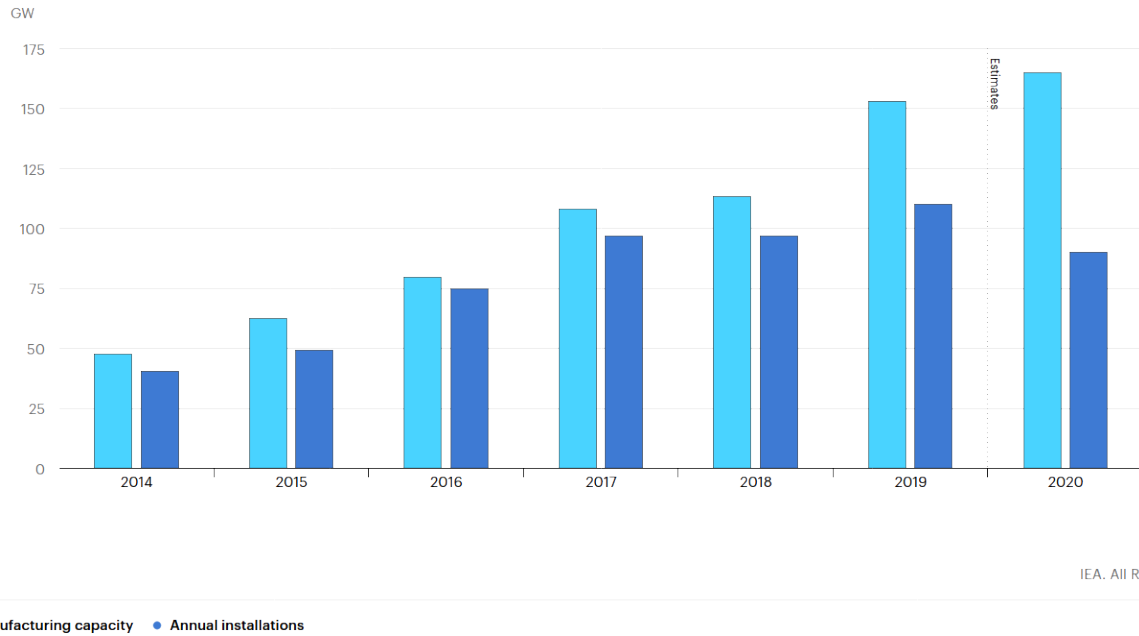


FIGURE 1 – Fabrication et demande des modules solaires photovoltaïques, 2014-2020. Source : IEA analysis based on Paula Mints (2020), The Solar Flare, SVP Market Research, San Francisco, CA [2]

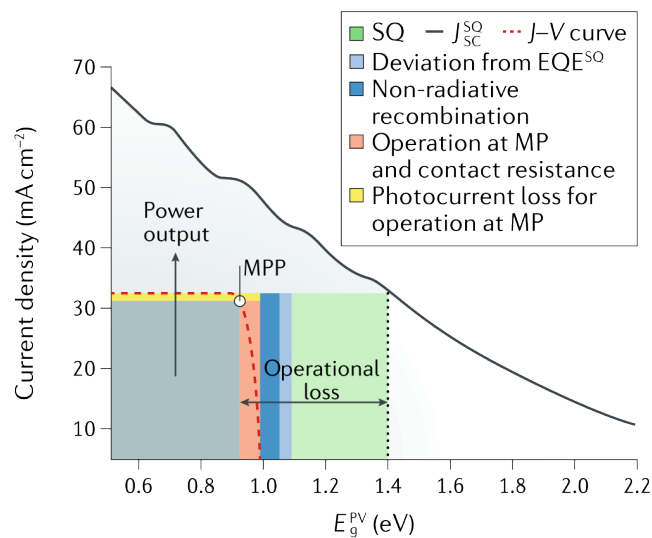


FIGURE 2 – Différence entre le formalisme de SQ et une cellule réelle. Le photo-courant maximal CC à la limite de Shockley-Queisser est tracé en fonction du gap (E_g^{PV}). La ligne pointillée en rouge indique la caractéristique J-V de la cellule [10]

Chapitre 1

Modèles à circuits électriques pour les cellules PV

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous parlerons des circuit électriques à éléments localisés qui sont utilisés pour la modélisation des cellules PV. Plus précisément, on discutera les modèles simple et double diode, les rôles et l'influence de chaque paramètre sur le modèle et finalement les techniques utilisées dans la littérature pour l'identification et l'estimation de ces paramètres.

1.2 Généralités

Fondamentalement, les cellules PV se composent de deux couches de semi-conducteurs à dopages différents, avec la jonction de ces deux couches étant exposée à la lumière incidente. En effet, les électrons dans la bande de conduction sont capables d'être transférés vers la bande de valence tant que l'énergie du photon incident $E = h\nu$ est supérieure à la largeur de la bande interdite $E_g = E_c - E_v$. Toute l'architecture d'une cellule quelconque vise à profiter le plus que possible de la différence de tension engendrée par les excitons séparés par le champ électrique dans la zone de déplétion (ou zone de charge d'espace) (figure 1.1). Par exemple, les contacts supérieurs sont des oxydes transparents conductifs (dit couche fenêtre) pour laisser passer le plus grand nombre de photons possible vers la couche absorbante de la cellule. Pour quelques cellule en couche mince, le contact arrière se compose d'une couche réfléchissante (ZnO et Ag ou Al) qui renvoie la lumière vers la couche absorbante pour minimiser davantage les pertes en lumière transmise [11].

En fait, le comportement électrique d'une telle cellule en l'absence de la lumière est identique à celui d'une diode PN classique dont la caractéristique est décrite par l'équation de Shockley (équation 1.1). Dans cette formule, le I_0 est le courant de saturation de la diode, q la charge élémentaire e^- , a le facteur d'idéalité, k la constante de Boltzmann et T la température de la cellule. Parfois on utilise la notion de *voltage thermique* : $V_t = \frac{kT}{q}$.

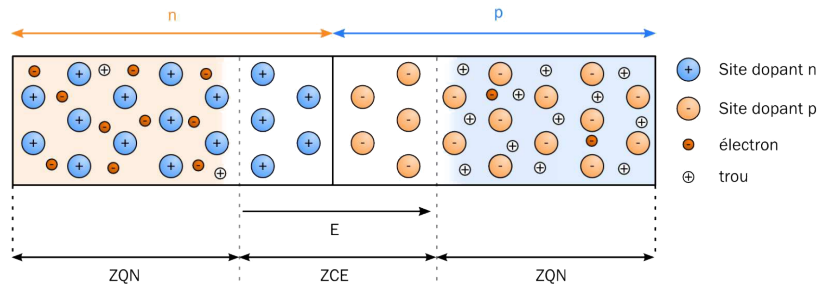
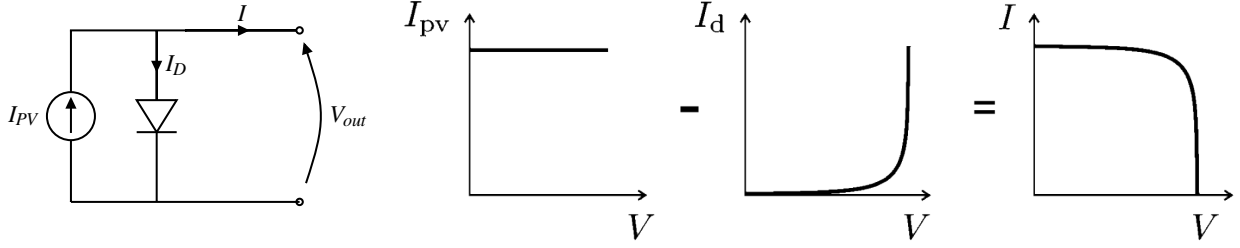


FIGURE 1.1 – Schéma d'une jonction PN représentant : la zone de charge d'espace (ZCE), les zones quasi-neutres (ZQN), les différents porteurs de charge, les sites dopants et le champ électrique E - Roger, 2013 [12].



(a) Modèle d'une cellule idéale

(b) Le courant I est la superposition de I_{PV} et de I_D [14]

FIGURE 1.2 – Modèle idéal d'une cellule PV

$$I_D = I_0 \left[e^{\left(\frac{qV}{akT} \right)} - 1 \right] \quad (1.1)$$

Bien que ces modèles d'éléments localisés sont efficaces et précis pour les cellules de première génération et celles en couches minces, il existe aujourd'hui plusieurs technologies émergentes qui n'utilisent pas le champ électrique de la zone de déplétion pour la séparation des charges, et utilisent d'autres mécanismes et sources de champ électrique comme par la divergence positive de la polarisation $\nabla \cdot \mathbf{P} \neq 0$ qui crée un déséquilibre de charges aux parois de domaines à polarisation différentes sein des matériaux ferroélectriques [13]. Pour ce genre de technologies, il est toujours difficile de concevoir un modèle de diode pour simuler le comportement complexe de ces cellules.

Avec la présence de la lumière, les photons assez énergétiques permettent la création des paires électron-trous qui, à leur tour, créent une différence de potentiel à travers la jonction. Une partie de ces porteurs de charge se recombine, mais l'autre se diffuse à travers les contacts de la cellule, ce qui donne naissance à un *photo-courant* I_{PV} dont la valeur dépend de l'intensité de la lumière incidente. En ajoutant le photo-courant I_{PV} à l'équation de Shockley 1.2, on retrouve un modèle élémentaire qui décrit une cellule idéale, composé d'une source de courant connectée à une diode en parallèle (figure 1.2.a). Évidemment ce modèle est complètement décrit par trois paramètres : (i) Le photo-courant I_{PV} , (ii) le facteur d'idéalité de la diode a et (iii) son courant de saturation I_0 .

$$I = I_{PV} - I_0 \left[e^{\left(\frac{qV}{akT} \right)} - 1 \right] \quad (1.2)$$

On voit dans la figure 1.2.b que la courbe caractéristique connue de la cellule se forme par une translation verticale par I_{PV} d'une part, et de la forme exponentielle de la diode de l'autre. Le facteur de courbure dans la région du point de puissance maximale est déterminée par le facteur d'idéalité de la diode.

1.3 Les modèles simple diode R_s et R_p

Le modèle idéal précédent est utile pour éclaircir le concept de la modélisation par circuits d'éléments localisés. Par contre, dans la pratique, et pour plus de précision, il est nécessaire de considérer les pertes ohmiques de la cellule dans le matériau semi-conducteur utilisé et dans les contacts des électrodes. La manière la plus directe de modéliser ces phénomènes est de tout simplement ajouter une résistance en série R_s au circuit idéal. Ceci nous laisse avec la relation modifiée 1.3 du modèle dit "*simple diode- R_s* " qui a besoin de 4 paramètres pour une description complète : I_{PV} , a , I_0 et R_s .

L'une des limites de ce modèle provient de son imprécision lorsque la cellule subit des variations non-négligeables de température. L'insertion d'une résistance shunt permet d'améliorer la sensibilité du modèle aux variations de température et en même temps de considérer tout courant de fuite pouvant traverser la jonction [15]. On se retrouve cette fois avec les 5 paramètres du modèle dit "*simple diode- R_p* " ou tout simplement "*simple diode*" : I_0 , I_{PV} , a , R_s et R_p . La relation entre ces paramètres est décrite par l'équation 1.4. Ce modèle offre un compromis entre la simplicité et la précision et par

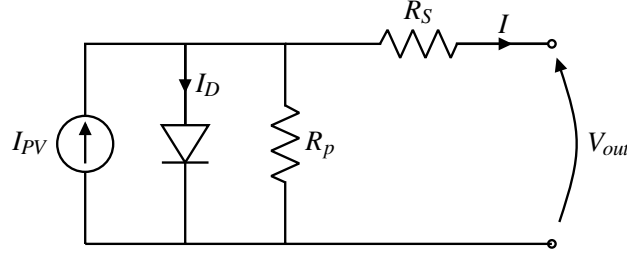


FIGURE 1.3 – Modèle Simple Diode

conséquent est très largement testé et utilisé dans la littérature [16]. Le diagramme du circuit de ce modèle est présenté dans la figure 1.3.

$$I = I_{PV} - I_0 \left[e^{\left(\frac{q(V+RS)}{akT} \right)} - 1 \right] \quad (1.3)$$

$$I = I_{PV} - I_0 \left[e^{\left(\frac{q(V+RS)}{akT} \right)} - 1 \right] - \frac{V + IR_S}{R_P} \quad (1.4)$$

1.4 Modèle double diode

Jusque là on a graduellement amélioré la performance et la précision des modèles de cellules PV en considérant de plus en plus de phénomènes physique qui se produisent dans la cellule (pertes ohmiques, effets des variations de température et courants de fuites). Un phénomène potentiellement influent qui n'est pas considéré par le modèle simple diode est celui des recombinaisons. Comme son nom l'indique, le modèle "*double diode*" (figure 1.4 n'est que qu'un modèle simple diode auquel on ajoute une autre diode en shunt pour mieux modéliser les effets de recombinaisons surtout aux conditions d'illumination faible [15].

Il est évident que l'addition d'une autre diode complique considérablement le modèle et on se retrouve avec deux paramètres supplémentaires (I_{PV} , I_{01} , I_{02} , a_1 , a_2 , R_S et R_P). Toutefois, dans les cas où la complexité des calculs associés n'est pas contraignante, la précision de se modèle est supérieure. L'équation 1.5 décrit la relation entre les 7 paramètres du modèle.

$$I = I_{PV} - I_{01} \left[e^{\left(\frac{q(V+RS)}{a_1 kT} \right)} - 1 \right] - I_{02} \left[e^{\left(\frac{q(V+RS)}{a_2 kT} \right)} - 1 \right] - \frac{V + IR_S}{R_P} \quad (1.5)$$

1.5 Influence des paramètres des modèles

Chacun des paramètres affecte le comportement du la cellule et la forme de la courbe caractéristique d'une manière différente. Tout d'abord, il faut noter que depuis l'équation 1.4, au point

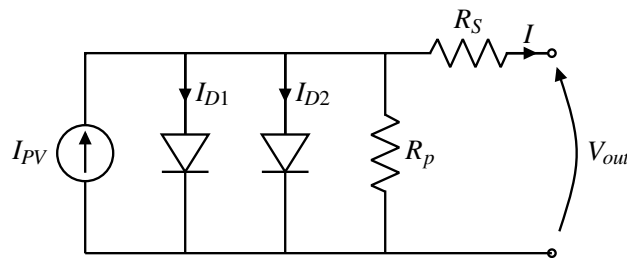
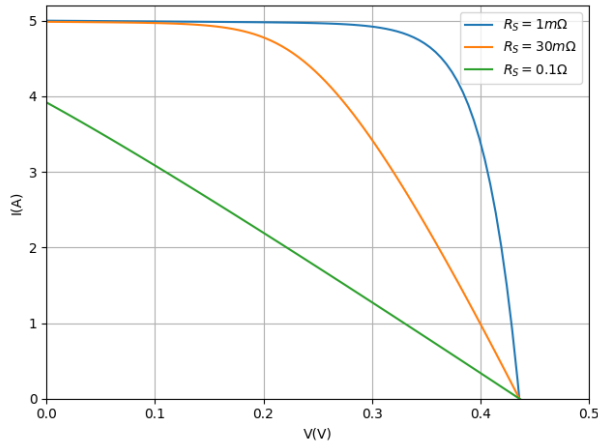


FIGURE 1.4 – Le modèle double diode

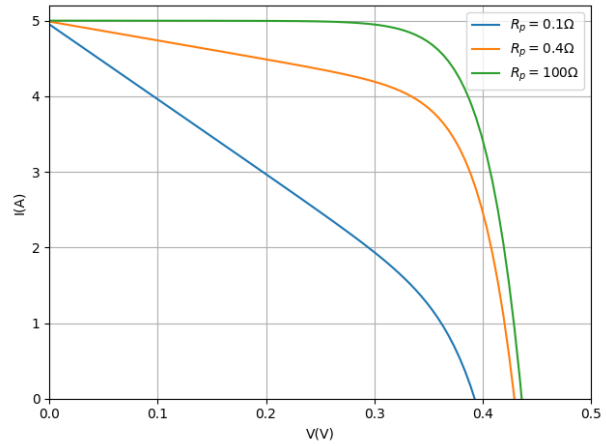
court-circuit, on peut négliger le courant de saturation I_0 devant le photo-courant I_{PV} qui est supérieur de plusieurs ordres de grandeur. Cette simplification mène au fait que le photo-courant détermine le courant court-circuit de la diode et $I_{PV} \approx I_{CC}$. C'est en fait une simplification que plusieurs méthodes analytiques emploient [17, 14]. En ce qui concerne la résistance série R_S , l'augmenter engendre une chute de tension entre la jonction et la sortie de la cellule. On voit dans la figure 1.5 la courbe se rapproche de plus en plus du comportement d'une résistance simple et que des valeurs très grande de R_S entraînent même une diminution légère de I_{SC} .

Pour la résistance shunt R_P , sa diminution conduit à un détournement d'une partie de plus en plus importante du courant sortant de la jonction, à travers la résistance en parallèle. Le courant total étant constant, le courant de sortie se retrouve de plus en plus réduit. Et comme dans le cas de la résistance série, une cellule avec beaucoup de pertes shunt à un comportement de plus en plus résistif (figure 1.5.b).

L'équation de Shockley (équation 1.1) est en fait retrouvée en négligeant toute recombinaison des porteurs de charges dans la zone de déplétion. Dans les diodes et les transistors réels, on constate une différence entre les courbes I-V et le modèle de Shockley [18]. Effectivement, le facteur d'idéalité modélise cette déviation du cas idéal. Une diode idéale est marquée par un facteur d'idéalité $a = 1$ alors qu'une diode où les événements de recombinaison dominant dans la zone de déplétion est marquée par $a = 2$. EXPLAIN WHY V_{oc} DECREASES + SAT CURRENT

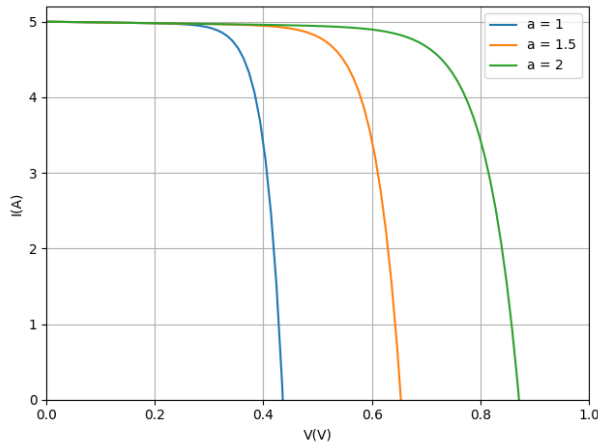


(a) Influence de R_S

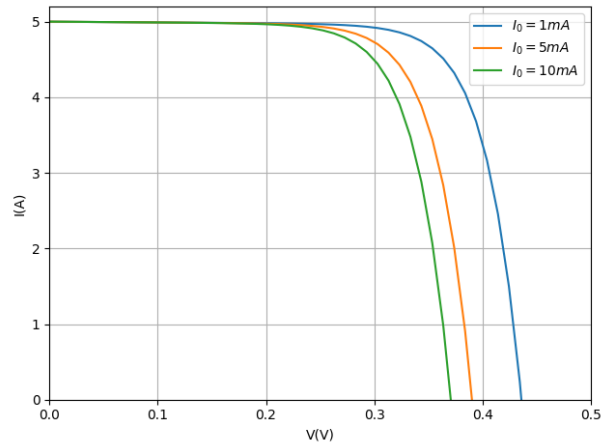


(b) Influence de R_P

FIGURE 1.5 – Influences de résistances du modèle sur la courbe caractéristique



(a) Influence du facteur d'idéalité



(b) Influence du courant de saturation

FIGURE 1.6 – Influence des paramètres de la diode sur la courbe I-V

1.6 État de l'art d'estimation des paramètres

Les paramètres (soit les valeurs des éléments localisés des circuits) représentent une description complète du modèle et une bonne estimation de leurs valeurs est essentielle avant leur application. On utilise souvent les données des data-sheets offertes par les fabricants des cellules et modules PV. Ces données couvrent les points clés de la caractéristique I-V (court-circuit, circuit ouvert et puissance maximale). Les méthodes analytiques tendent à utiliser ces informations en plus de quelques expressions comme la pente de la courbe aux points clés pour déterminer les résistances en shunt R_P et en série R_S . On trouve souvent aussi des simplifications comme le fait de considérer que seuls les I_{PV} et I_0 sont significativement influents sur la caractéristique [19]. Dans le modèle simple diode contenant les 5 paramètres I_{PV} , I_0 , a , R_S et R_P , il est très courant de tout simplement négliger I_0 devant I_{PV} au point court circuit, et par conséquent considérer que $I_{PV} = I_{CC}$ (La valeur de I_0 est ensuite extraite des conditions circuit ouvert) [14, 19, 17]. En ce qui concerne a , R_S et R_P , on a besoin de davantage d'équations. Généralement, les chercheurs utilisent soit les dérivées de la caractéristique aux points clés, soit des expressions analytiques des coefficients de température le liant avec les paramètres. Le problème étant de nature non-linéaire, les techniques d'optimisation avec des capacités de recherche globales dans l'espace de recherche s'offrent comme alternative. La précision de ces techniques dépend évidemment de la fonction objectif considérée, des conditions initiales et de la nature de l'algorithme lui-même [20, 21, 22]. Les techniques de calcul souple et les algorithmes évolutionnistes ont susciter beaucoup d'intérêt récemment dans la littérature dans le but d'estimer les paramètres des cellules PV. Des techniques de réseaux de neurones artificiels [23, 24, 25], logique floue [26, 27, 28], algorithme génétique [29, 30, 31], optimisation par essaims particulaires (Particle Swarm Optimization) [32, 33] et évolution différentielle [22, 34, 35] ont été utilisées. Par contre elles ne sont pas utilisées par les simulateurs PV, qui sont contraints par des critères de consistance et de temps de calcul, à cause de leurs nature stochastique. Ceci dit, elles sont très utiles lorsqu'il y a un besoin de précision sur les paramètres pour servir à l'optimisation du processus de fabrication ou pour l'étude de dégradation des cellules [36, 23]. Dans les chapitres suivants nous allons présenter et analyser une méthode utilisant l'algorithme d'évolution différentielle qui est relativement récente en la comparant avec d'autre algorithmes similaires.

1.7 Conclusion

Chapitre 2

Évolution Différentielle

2.1 Introduction

L'Évolution Différentielle (ED) est un algorithme évolutionnaire développé par Storn et Price [37] en 1995. Il est versatile et relativement simple à implémenter et utiliser, ce qui en fait un outil essentiel dans toute boîte à outils d'optimisation. Comme toutes les techniques évolutionnaires, le principe de l'évolution différentielle repose sur la génération d'une population de N_P solutions (ou "vecteurs") qui permettent d'évaluer une fonction objectif à des points initiaux distribués aléatoirement dans un espace de recherche borné selon l'utilisateur. Ces points sont "perturbés" dans les générations successives de la population pour essayer de trouver des solutions extrémisant la fonction objectif. L'une des caractéristiques qui font la particularité de tout algorithme évolutionnaire est l'opération utilisée pour effectuer cette perturbation. Dans le cas de l'évolution différentielle, on perturbe une solution avec la différence de deux autres vecteurs de la population, multipliée par un facteur F , c'est l'opération dite de "mutation" comme est présenté dans la figure 2.1. Ce nouveau vecteur subit une opération de croisement avec le vecteur initial pour produire le vecteur d'essai qui est comparé avec le vecteur de même indice dans la population. Ceci est refait jusqu'à ce que tous les vecteurs de la population soient comparés avec un vecteur d'essai (soit N_P fois), créant la génération suivante. L'algorithme continue de créer de plus en plus de générations jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt est satisfait. Souvent c'est un nombre de générations maximal ou une valeur de tolérance pour la variation de la fonction objectif.

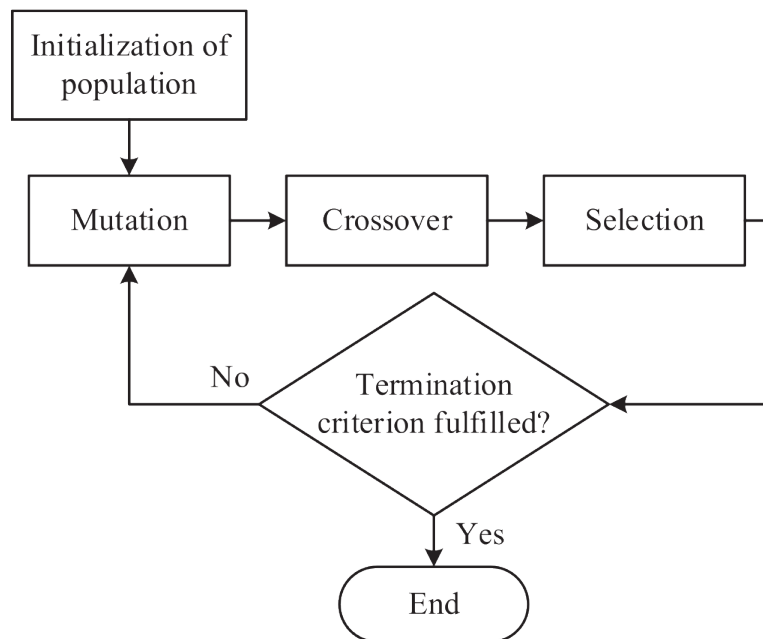


FIGURE 2.1 – Organigramme des étapes de l'Évolution Différentielle [38]

2.2 Description de l'algorithme

2.2.1 Initialisation

La convergence des techniques d'optimisation non-linéaires est toujours conditionnée par un "bon" choix des conditions initiales. Dans le cas de l'évolution différentielle, il s'agit de l'ensemble des vecteurs constituant la population initiale. Si un vecteur solution quelconque se constitue de D paramètres, notre espace de recherche est dit à D dimensions, ce qui fait que notre population initiale se compose de N_p vecteurs à D éléments. Mais pour pouvoir effectuer l'initialisation de la population, les bornes de l'espace de recherche doivent être spécifiées. Chacun des D paramètres doit avoir une borne supérieure et inférieure, ce qui fait un total de $2 \times D$ valeurs pour spécifier complètement les limites de l'espace. Reste le mécanisme utilisé pour effectivement générer les vecteurs dans cet espace borné. Pour couvrir entièrement et uniformément cet espace, il faut, pour chaque paramètre de chaque vecteur, générer aléatoirement et uniformément une valeur comprise dans la fourchette déterminée par un générateur de nombres aléatoires. En considérant que l'indice j associé à un vecteur \vec{V} désigne le j -ème paramètre, on peut accomplir ceci avec la formule 2.1.

$$V_j = V_{\min,j} + \text{rand}[0, 1](V_{\max,j} - V_{\min,j}) \quad (2.1)$$

On suppose avoir accès à une fonction $\text{rand}[0, 1]$, qui joue le rôle du générateur de nombres aléatoires uniformes et que $0 \leq \text{rand}[0, 1] < 1$. $V_{\min,j}$ et $V_{\max,j}$ sont les bornes inférieures et supérieures du j -ème paramètres, respectivement. Figure 2.2 montre un exemple d'une population initialisée dans un espace de recherche 2 dimensionnel. Les contours sont les "isolignes" de la fonction objectif, le minimum global doit être à l'intérieur de la fourchette spécifiée.

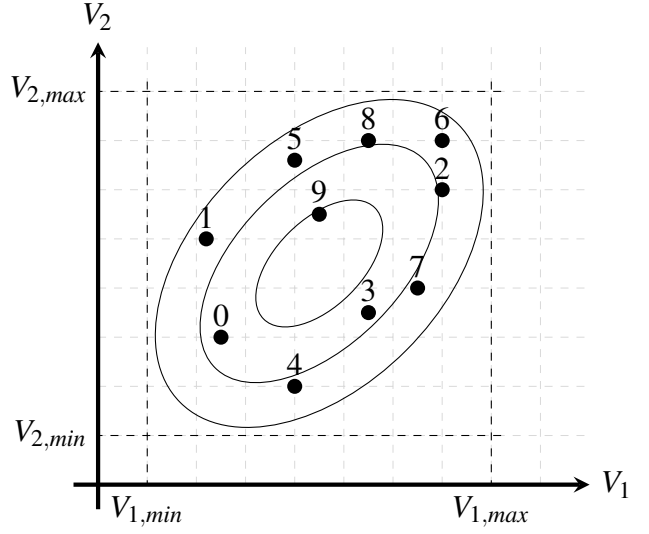


FIGURE 2.2 – Exemple d'une population initialisée dans un espace de recherche à deux dimensions. Dans ce cas $D = 2$, $N_p = 10$ et l'indice de génération $g = 0$ puisqu'il s'agit de la population initiale

2.2.2 Mutation

Après l'initialisation de la population, l'ED modifie, croise et recombine la population pour produire des vecteurs d'essai (un nombre N_P de ces vecteurs) qui seront comparés avec les vecteurs cibles qui leurs correspondent dans la population. La *Mutation* dans l'ED est en fait une "mutation différentielle". Elle consiste à ajouter la différence de deux vecteurs choisis aléatoirement de la population, multipliée par un facteur de pondération ou "Facteur de Mutation", à un troisième vecteur de base distinct. Cette opération produit un vecteur mutant M selon l'équation 2.2. L'indice i indique le i -ème vecteur de la population, et gen la génération où l'on est. Il n'y a pas de limite dure sur le Facteur de Mutation F , mais les valeurs supérieures à 1 sont rarement considérées. Dans notre cas, on considère que $F \in [0, 1]$. Il existe plusieurs stratégies pour choisir le \vec{V}_{base} , le seul prérequis étant qu'il soit distinct du vecteur cible. Dans ce travail nous utiliserons exclusivement le choix du vecteur ayant la meilleure qualité ou valeur de "fitness" calculée par la fonction objectif. Les vecteurs de la différence $\vec{V}_{r1,gen}$ et $\vec{V}_{r2,gen}$ sont choisis aléatoirement de la population pour chaque vecteur mutant et ne doivent qu'être distincts l'un de l'autre et des vecteurs cible $\vec{V}_{i,gen}$ et de base $\vec{V}_{base,gen}$.

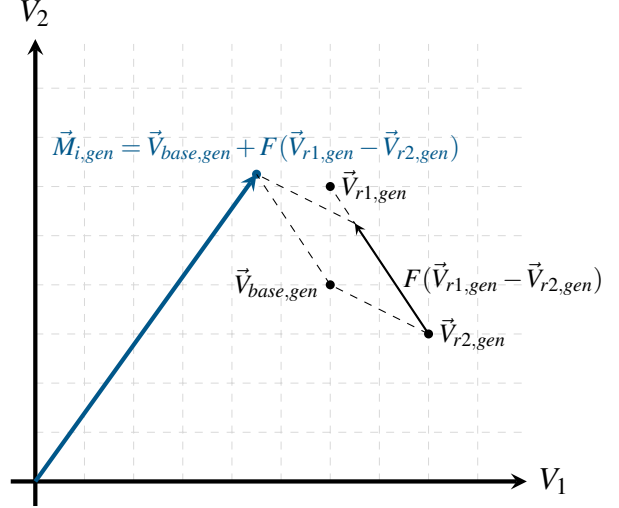


FIGURE 2.3 – L'opération de mutation différentielle ajoute $F(\vec{V}_{r1,gen} - \vec{V}_{r2,gen})$ au vecteur de base $\vec{V}_{base,gen}$ pour produire un mutant $\vec{M}_{i,gen}$

$$\vec{M}_{i,gen} = \vec{V}_{base,gen} + F(\vec{V}_{r1,gen} - \vec{V}_{r2,gen}) \quad (2.2)$$

2.2.3 Croisement

La opération de mutation est suivie d'un croisement ou *recombinaison discrète*. Elle consiste à construire le vecteur d'essai $\vec{T}_{i,gen}$ à partir des éléments (i.e. paramètres) de deux vecteurs différents selon une probabilité spécifiée. Chaque élément j du vecteur d'essai est choisi selon la formule 2.3

$$T_{j,i,gen} = \begin{cases} M_{j,i,gen} & \text{si } \text{rand}[0, 1] \leq CR \text{ ou } j = j_{rand} \\ V_{j,i,gen} & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.3)$$

$CR \in [0, 1]$ détermine la probabilité que le paramètre provienne du vecteur mutant tant que $\text{rand}[0, 1]$ est effectivement un générateur aléatoire uniforme. Le taux de croisement CR est l'un des paramètres spécifiés par l'utilisateur au début. Un nombre aléatoire j_{rand} est aussi choisi tel que $0 \leq j_{rand} < D$ pour s'assurer que le nouveau vecteur d'essai ne duplique pas complètement le vecteur cible $\vec{V}_{i,gen}$.

2.2.4 Sélection

Si le vecteur d'essai $\vec{T}_{i,gen}$ est évalué à une valeur inférieure par la fonction objectif f au vecteur cible $\vec{V}_{i,gen}$, il le remplace dans la génération suivante (i.e. $gen + 1$). Sinon le vecteur cible survit à la sélection et retient sa place dans la génération suivante (équation 2.4). Quand la nouvelle population est complète, le processus de mutation, croisement et sélection est renouvelé jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt est vérifié (e.g. un nombre maximal de générations gen_{max})

$$\vec{V}_{i,gen+1} = \begin{cases} \vec{T}_{i,gen} & \text{si } f(\vec{T}_{i,gen}) \leq f(\vec{V}_{i,gen}) \\ \vec{V}_{i,gen} & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.4)$$

2.3 Remarques

On vient de citer toutes les étapes de l'ED "classique" comme elle a été présentée par Storn et Price 2005 [39]. Cependant il existe plusieurs variations ou "stratégies" de l'ED selon la manière avec laquelle on choisit le vecteur de base avant la mutation, le nombre de différences pondérées ajoutées et la méthode de croisement. Nous avons opté à choisir le vecteur à meilleure valeur de fitness comme vecteur de base, auquel on ajoute une seule différence de vecteurs pondérée par F , et finalement un croisement binomial. Le mot technique pour cette stratégie est "DE/best/1/bin" dont une démonstration en pseudocode est dans l'algorithme 1.

Il faut aussi noter que cet algorithme comme il est, n'est contraint nul part à ne générer que des solutions comprises dans les limites initiales de l'espace de recherche. Ceci présente en fait un avantage de l'ED puisque ça permet d'explorer les zones au-delà des limites de la population initiale pour potentiellement trouver un minimum global qu'on est pas toujours assurés qu'il soit dans la zone initiale. Cependant, on peut tomber sur des solutions non "physiques" et qui ne présentent aucun intérêt pour notre application. Storn et Price citent plusieurs techniques pour résoudre ce problème, mais dans notre cas on effectue un test sur chaque vecteur mutant. Si un de ses paramètres se retrouve à l'extérieur des limites spécifiées de l'espace de recherche, on le pénalise en imposant une valeur de fitness assez large pour éliminer les chances que ce vecteur pourra survivre vers la génération suivante.

Dans notre application de l'ED sur le problème d'identification des paramètres de modèles à diodes, nous prenons l'approche d'un problème d'optimisation. En effet, un vecteur solution se constitue de tous les paramètres nécessaires pour une description complète du modèle équivalent, c'est-à-dire un espace de recherche à $D = 5$ dimensions dans le cas du modèle simple diode (R_p), et à $D = 7$ dimensions dans le cas du modèle double diode. La fonction objectif à minimiser devrait être une mesure de la différence entre la courbe I-V du modèle et celle de la cellule expérimentale. La méthode la plus répandue pour quantifier cette différence est la racine de l'erreur quadratique moyenne ou *Root Mean Squared Error*. L'erreur d'un vecteur \vec{V}_{sol} est donnée par l'équation 2.5 où l'indice i indique un point dans la courbe caractéristique I-V.

$$f(\vec{V}_{sol}) = RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_{i,exp} - I_{i,cal}(\vec{V}_{sol}))^2} \quad (2.5)$$

2.4 Conclusion

Algorithme 1 : Stratégie DE/best/1/bin

```
 $F \leftarrow$  Facteur de mutation;  
 $CR \leftarrow$  Taux de croisement;  
 $N_P \leftarrow$  Taille de la population;  
 $gen_{max} \leftarrow$  Nombre de générations;  
 $D \leftarrow$  Nombre de paramètres;  
 $gen = 0$ ;  
Initialize population  $P_0 = [V_0, V_1, \dots, V_{N_P}]$ ;  
for  $i = 0$  to  $N_P$  do  
     $V_{min} = [V_{1,min}, V_{2,min}, \dots, V_{D,min}]$ ;  
     $V_{max} = [V_{1,max}, V_{2,max}, \dots, V_{D,max}]$ ;  
     $V_i = V_{min} + \text{rand}[0, 1](V_{max} - V_{min})$ ;  
end for  
while  $gen < gen_{max}$  do  
    for  $j = 0$  to  $N_P$  do  
         $V_{j,gen} = [V_{1,j,gen}, V_{2,j,gen}, \dots, V_{D,j,gen}]$ ;  
        Choisir le vecteur de base et deux vecteurs aléatoires  $V_{r1}$  et  $V_{r2} \in P_{gen}$ ;  
         $V_{base} = V \in P_{gen} \mid \forall (K \in P_{gen}), f(V) \leq f(K)$ ;  
        Mutation :  
         $M_{j,gen} = V_{base} + F(V_{r1} - V_{r2})$ ;  
        Croisement :  
         $T_{j,gen} = [T_{1,j,gen}, T_{2,j,gen}, \dots, T_{D,j,gen}]$ ;  
        if  $\text{rand}[0, 1] < CR$  or  $j = j_{rand}$  then  
             $T_{i,j,gen} = M_{i,j,gen}$ ;  
        else  
             $T_{i,j,gen} = V_{i,j,gen}$ ;  
        end if  
        Selection :  
        if  $f(T_{j,gen}) < f(V_{j,gen})$  then  
             $V_{j,gen+1} = T_{j,gen}$ ;  
        else  
             $V_{j,gen+1} = V_{j,gen}$ ;  
        end if  
    end for  
     $gen = gen + 1$ ;  
end while
```

Chapitre 3

Évolution Différentielle sur les circuits simple et double diodes

3.1 Introduction

Maintenant que nous avons abordé les modèles à diodes et l'Évolution Différentielle indépendamment l'un de l'autre, dans ce chapitre nous allons appliquer l'ED sur les modèles pour estimer les valeurs des paramètres en utilisant les données expérimentales standards de la littérature. En ce qui concerne l'implémentation pratique de cette technique, on utilise le langage de programmation *Python*. On fait appel à quelques bibliothèques scientifiques de Python pour fournir les outils mathématiques requis par la méthode. À partir d'ici nous allons fournir des petits extraits de code pertinents à la discussion qui montrent la manière d'implémenter les étapes de la méthode. Pour des raisons de clarté ce ne sont pas des extraits complètement fidèles au code utilisé en réalité. Le code complet et non modifié est disponible comme annexe à la fin de ce document.

3.2 Fonction W de Lambert

Les méthodes évolutionnaires dépendent d'une fonction objectif qu'il faut minimiser, pour sélectionner les meilleures solutions dans une population. Dans notre cas, la fonction objectif est la *RMSE* et elle quantifie la différence entre la courbe caractéristique du modèle et les données expérimentales. Cependant, chaque fois qu'un vecteur solution \vec{V} (formules 3.1) est généré, il faut pouvoir recréer la courbe I-V associée pour permettre à la fonction objectif de calculer la RMSE.

$$\vec{V}_{\text{simple diode}} = \begin{bmatrix} R_s \\ R_p \\ a \\ I_0 \\ I_{PV} \end{bmatrix}, \quad \vec{V}_{\text{double diode}} = \begin{bmatrix} R_s \\ R_p \\ a_1 \\ a_2 \\ I_{01} \\ I_{02} \\ I_{PV} \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

On pourrait implémenter la fonction objectif en code de la manière suivante :

```
1 # Cette fonction prend un vecteur solution et les points IV expérimentaux comme arguments
2 def objf(vecteur, exp_v, exp_i):
3     # Pénalisons le vecteur si les valeurs sont non-physiques
4     rs, rp = vecteur[0], vecteur[1]
5     if rs < 0 or rp < 0:
6         return 100 # Valeur fitness large
7     ical = i_from_vect(vecteur, exp_vol) # Une fonction donnant la caractéristique IV de "vector"
8     erreur = ical - exp_i
9     return np.sqrt(np.mean(erreur ** 2)) # RMSE
```

Les équations de modèles simple et double diode (équations 1.4, 1.5, respectivement) sont transcendantes, il est donc impossible d'extraire directement le courant à partir de la tension et des paramètres (Le courant I figure simultanément dans le premier membre et dans l'exponentiel du second).

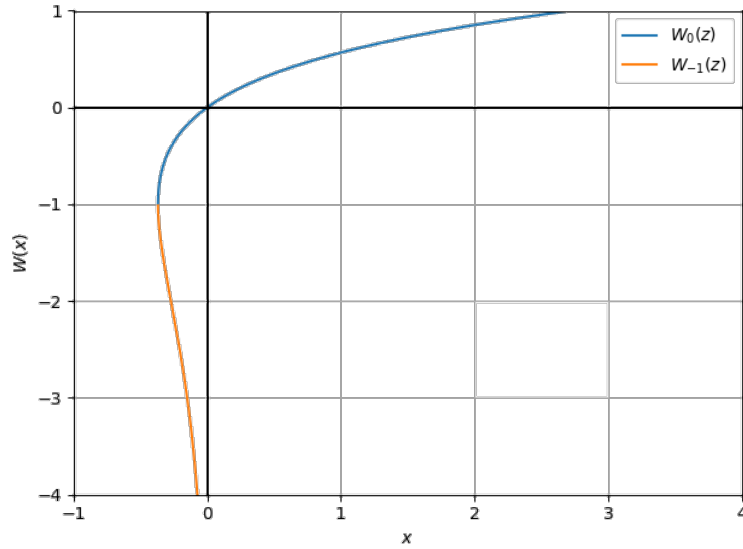


FIGURE 3.1 – Les deux branches réelles de $W(x)$ lorsque x est réel

Ainsi, il n'est pas trivial de remplir la fonction de `i_from_vect(vector, exp_vol)`. Plusieurs méthodes ont été utilisées initialement avec des approches d'approximation analytique ou itérative [40, 41, 42]. Ces méthodes sont approximatives mais permettent de trouver la solution explicitement avec des fonctions élémentaires (Développement Taylor par exemple). Dans notre cas, on fait recours à la méthode de Jain et Kapoor (2004) [43, 44] qui utilisent la fonction W de Lambert pour une solution analytique exacte de ces équations.

3.2.1 Définition

La "fonction W " de Lambert est définie comme l'inverse de la fonction $w \rightarrow f(w) = we^w$, où $w = W_k(z) \mid z \in \mathbb{C}$. La fonction f n'étant pas surjective, la fonction $W_k(z)$ est donc *multivaluée* et comprends plusieurs branches indexées par k (W_0 est choisie comme branche principale). Si $x \in \mathbb{R}$ et $-1/e \leq x < 0$, il existe deux valeurs réelles possible de $W(x)$ (figure 3.1).

3.2.2 Évaluation de la fonction W

Le fait qu'il n'existe pas de fonctions mathématiques élémentaires donnant explicitement $W(z)$ est remédié par l'existence de plusieurs *algorithmes de recherche des zéros* permettant le calcul des valeurs de n'importe quelle branche de la fonction W . Dans notre cas spécifique, la bibliothèque scientifique *scipy* de Python fournit une fonction W implémentée par l'itération de Halley qui est un exemple d'une méthode de classe "Householder"¹. La méthode de Halley a été appliquée à la fonction W par Corless et al. [45] donnant :

$$w_{j+1} = w_j - \frac{w_j e^{w_j} - z}{e^{w_j}(w_j + 1) - \frac{(w_j+2)(w_j e^{w_j} - z)}{2w_j+2}} \quad (3.2)$$

Un exemple basique de l'utilisation de cette méthode en Python est le suivant :

```

1 import numpy as np
2 from scipy.special import lambertw # scipy fournit la fonction W
3
4 z = np.linspace(-1/np.e, 3, 1000) # évaluons W entre -1/e et 3
5 w0 = lambertw(z, 0) # choisir la branche principale

```

1. La méthode de Newton est un exemple d'une méthode de Householder

3.2.3 Résolution des modèles simple et double diode par la fonction W

Depuis la définition de la fonction W , la solution d'une équation $xe^x = a$ est $x = W(a)$. En effectuant des manipulations algébriques élémentaires sur le modèle simple diode (equation 1.4), Jain et Kapoor ont montré que l'expression explicite du courant en fonction des paramètres et de la tension est :

$$I = \frac{R_{sh}(I_0 + I_{PV}) - V}{R_s + R_{sh}} - \frac{W\left(\frac{R_s I_0 R_{sh}}{a V_{th}(R_s + R_{sh})} e^{\left(\frac{R_{sh}(R_s I_{PV} + R_s I_0 + V)}{a V_{th}(R_s + R_{sh})}\right)}\right) a V_{th}}{R_s} \quad (3.3)$$

On remarque bien que le second membre ne contient nul part un terme de courant I . Il faut noter aussi que le terme de la fonction W est sous risque d'un dépassement et de retourner des valeurs infinies. Pour des raisons de stabilité numérique on utilise la notion de *Conductance Shunt* : $C_{sh} = \frac{1}{R_{sh}}$ car cette résistance prend souvent de valeurs $\gg 1$ ce qui entraîne un risque de divergence des calculs. On trouve souvent des valeurs larges de résistance shunt, ce qui explique l'existence dans la littérature de plusieurs modèles utilisant la simplification $R_{sh} = +\infty$. Avec la substitution de la conductance shunt, si $R_{sh} \rightarrow \infty$ alors $C_{sh} \rightarrow 0$ ce qui assure la stabilité du calcul numérique.

Le modèle double diodes (équation 1.5) contient un terme exponentiel pour chaque diode. De la même manière que Jain et Kapoor on retrouve explicitement l'expression du courant avec deux termes de la fonction W (equation 3.4).

$$I = \frac{R_{sh}(I_{01} + I_{02} + I_{PV}) - V}{R_s + R_{sh}} - \frac{a_1}{2R_s} W\left(\frac{R_s R_{sh}(I_{01} + I_{02})}{a_1(R_s + R_{sh})} e^{\left(\frac{R_{sh}(R_s I_{PV} + R_s I_{01} + R_s I_{02} + V)}{a_1(R_s + R_{sh})}\right)}\right) - \frac{a_2}{2R_s} W\left(\frac{R_s R_{sh}(I_{01} + I_{02})}{a_2(R_s + R_{sh})} e^{\left(\frac{R_{sh}(R_s I_{PV} + R_s I_{01} + R_s I_{02} + V)}{a_2(R_s + R_{sh})}\right)}\right) \quad (3.4)$$

3.3 Résultats

3.3.1 Configuration de l'Évolution Différentielle

Pour appliquer l'Évolution Différentielle avec succès sur les modèles à diodes, il faut savoir choisir les bonnes valeurs de paramètres de contrôle CR , F et N_p . Il n'existe pas de règle stricte mais Storn et Price [39] donnent quelques indications. En ce qui concerne le facteur de mutation F , les valeurs $F \geq 1$ ne sont pas fiables et souvent convergent très lentement par rapport aux $F < 1$. Cependant, Zaharie (2002) [46] constate une borne inférieure de $F > 0.4$. Puisque l'opération de *sélection* tend à réduire la diversité dans la population, le rôle de la *mutation* et de balancer cette pression exercée sur la population et tend à augmenter la diversité. Si F est trop petit, l'ED peut converger même avec l'absence de la pression sélective. En ce qui concerne le taux de croisement CR , Salomon (1996) [47] a démontré les limites d'un CR trop petit et par conséquent Storn et Price recommandent des valeurs de CR proche de 1. Reste à choisir la taille de la population N_p , généralement $10D \leq N_p \leq 20D$ est recommandé mais dans notre cas on optera à $N_p = 100$.

3.4 Utilisation de l'outil DEPV

Dans ce projet, nous avons développé une bibliothèque en Python fournissant une interface permettant de lancer des calculs avec la technique de l'ED sur n'importe quelles cellule, à condition d'avoir accès aux données expérimentales. On fournit la fonction `read_csv()` qui permet à l'utilisateur d'extraire les points expérimentaux de la caractéristique IV (voltage en abscisses et courant en ordonnées) à partir d'un fichier .txt ou .csv. Nous fournissons aussi une classe `DE` qui gère tous les calculs. Il suffit de lui donner les paramètres nécessaires tel que les bornes de l'espace de recherche

et le fichier contenant les données expérimentales. Pour plus de contrôle sur les paramètres de l'algorithme, la classe DE expose plusieurs variable à travers son "constructeur". Le prototype de la fonction constructrice ou `__init__()` est le suivant :

```

1  def __init__(self, bounds, ivdata, Ns, Np, temp, popsize=100, maxiter=200, mutf=0.7, crossr=0.8):
2      """
3          :param bounds: Dictionary of bounds in this form {'rp': [lower, upper], 'rs': [lower, upper] ...}
4          :param ivdata: [Voltages, Currents]
5          :param Ns: Number of cells in series
6          :param Np: Number of cells in parallel
7          :param temp: Temperature
8          :param popsize: Population size
9          :param maxiter: Maximum number of generations
10         :param mutf: Mutation Factor F
11         :param crossr: Crossover Rate CR
12         """

```

Notons les valeurs prise par défaut pour la taille de la population $N_p = 100$, le nombre de générations maximal $Gen_{max} = 200$, le facteur de mutation $F = 0.7$ et le taux de croisement $CR = 0.8$. Si l'utilisateur ne fournit pas explicitement ces paramètres, les valeurs par défaut sont alors utilisées. Un exemple d'exécution de la classe DE sur la cellule est le suivant :

```

1  # On importe la classe DE et la fonction read_csv()
2  from objects import DE, read_csv
3
4  # Bornes de l'espace de recherche
5  bornes = {'rp': [2, 100],
6            'rs': [0, 1],
7            'a': [1, 2],
8            'i0': [1e-07, 1e-04],
9            'ipv': [0, 10]}
10
11 # Température en K et nombre de cellules en serie et en parallele
12 T = 33 + 275.15
13 Ns, Np = 1, 1
14
15 # Données expérimentales disponible dans un fichier .csv
16 exp = read_csv("data/RTC33D1000W.csv")
17
18 # On crée un objet DE pour utiliser ces données et effectuer le calcul
19 RTC = DE(b, exp, Ns, Np, T)
20
21 # On lance le calcul
22 RTC.solve()
23
24 # Traçage des graphes et résultats
25 RTC.plot_fit_hist()
26 RTC.plot_result(print_params=True)

```

Si on veut utiliser le modèle double diode, il suffit de donner 7 intervalles au lieu de 5 comme dans l'exemple précédent. DEPV reconnaît automatiquement le modèle à utiliser à partir de la taille du dictionnaire bornes fournit à la classe DE :

```

1  b = {'rp': [2, 100],
2       'rs': [0, 1],
3       'a1': [1, 2],
4       'a2': [1, 2],
5       'i01': [1e-7, 1e-5],

```

```

6      'i02': [1e-7, 1e-5],
7      'ipv': [0, 5]}
8
9  T = 45 + 275.15
10 Ns, Np = 36, 1
11 exp = read_csv("data/PWP.csv")
12
13 PWP = DE(b, exp, Ns, Np, T)
14
15 PWP.solve()
16 PWP.plot_fit_hist()
17 PWP.plot_result(print_params=True)

```

Dans le cas où on n'a pas besoin d'accéder à cette fonctionnalité programmatiquement, il suffit d'utiliser directement l'interface graphique de DEPV. On a toujours besoin de fournir le fichier contenant les données expérimentales, la température, les bornes et les cellules en série et en parallèle (figure 3.2). Les résultats et les graphes sont affichés par l'interface dans la figure 3.3

The screenshot shows the 'Main' window of the DEPV tool. It features a list of parameters on the left and a table of bounds on the right. The parameters are: Shunt Resistance Rp, Series Resistance Rs, Ideality Factor a, Saturation Current I0, Photocurrent Ipv, Temperature (°C), Number of cells in series, Number of cells in parallel, and I-V curve file location. The table has two columns: 'Lower Bound' and 'Upper Bound'. The values in the table are: 2, 100, 0, 1, 1, 2, 1e-07, 1e-04, 0, 10, 33, 11, 1, and a 'Select File' button. A 'Calculate' button is at the bottom.

	Lower Bound	Upper Bound
Shunt Resistance Rp:	2	100
Series Resistance Rs:	0	1
Ideality Factor a:	1	2
Saturation Current I0:	1e-07	1e-04
Photocurrent Ipv:	0	10
Temperature (°C):	33	
Number of cells in series	11	
Number of cells in parallel	1	
I-V curve file location:	Select File	

Calculate

FIGURE 3.2 – Interface principale de l'outil DEPV avec les champs texte pour insérer les bornes, la température, les cellules en séries/parallèle et le fichier .csv contenant les données expérimentales

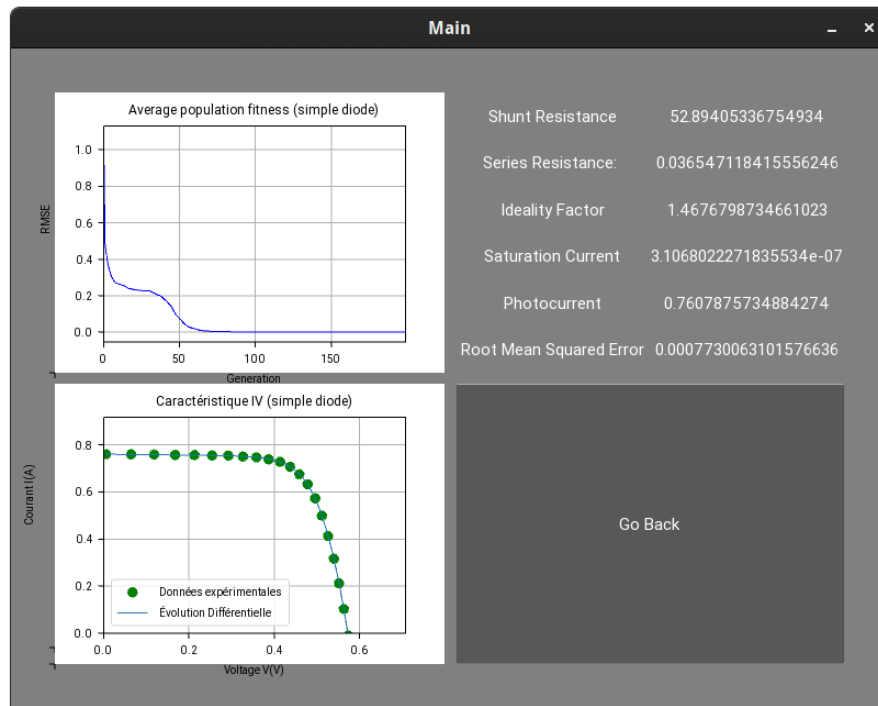


FIGURE 3.3 – Graphes et résultats affichés par DEPV pour la cellule RTC France 57 mm

3.5 Conclusion

Chapitre 4

Résultats et analyse

4.1 Introduction

4.2 Cas 1 : Cellule 57-mm de RTC France

Ce premier cas d'étude concerne la cellule en silicium de RTC France avec un diamètre de 57 mm qui a été très largement étudiée dans la littérature. Sa courbe caractéristique a été mesurée dans des conditions de température $T = 33^\circ\text{C}$ et irradiance solaire 1000 W m^{-2} et comprend 26 points expérimentaux (figure 4.1). Figure 4.2.a montre que la caractéristique expérimentale et calculée par l'ED sont graphiquement quasi-identiques. Figure 4.2.b montre l'évolution de la moyenne des valeurs de fitness des vecteurs évalués par la fonction objectif dans chaque génération consécutive. On constate que dès la 50^{ème} génération, l'ED a pratiquement déjà convergé.

Le tableau 4.2 présente une comparaison entre l'ED et d'autres méthodes appliquées à la cellule RTC France. On constate que les valeurs retrouvées par l'ED sont assez proches de celles des autres travaux. En effet, l'ED parvient à une erreur RMSE de 7.7692×10^{-4} qui est supérieure aux autres techniques similaires comme les essais particuliers [48], l'algorithme des colonies d'abeilles artificielles [49] et l'ED à trois points [38]. Les résultats les moins précis sont ceux de la méthode de Newton à moindres carrés [20].

TABLEAU 4.1 – Bornes utilisées de l'espace de recherche pour le modèle simple diode

Paramètre	R_s	R_{sh}	a	I_0	I_{PV}
Borne supérieure	1	100	2	1×10^{-6}	10
Borne inférieure	0	2	1	1×10^{-7}	0

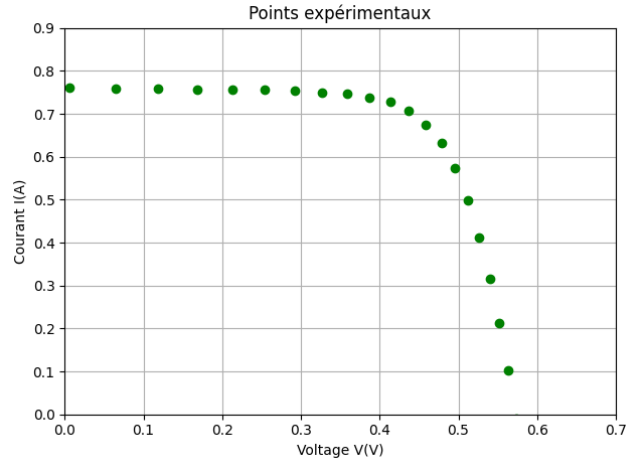
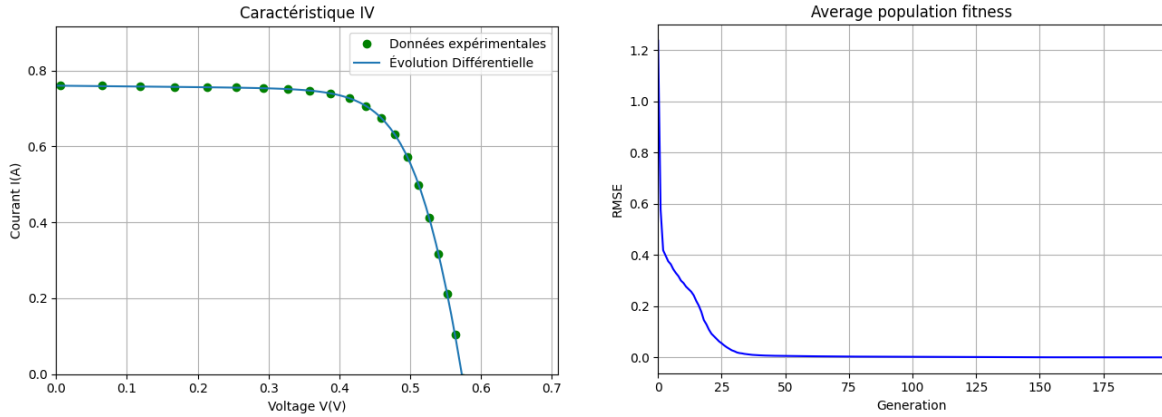


FIGURE 4.1 – Données expérimentales de la caractéristique IV de la cellule RTC France mesurées à 33 °C



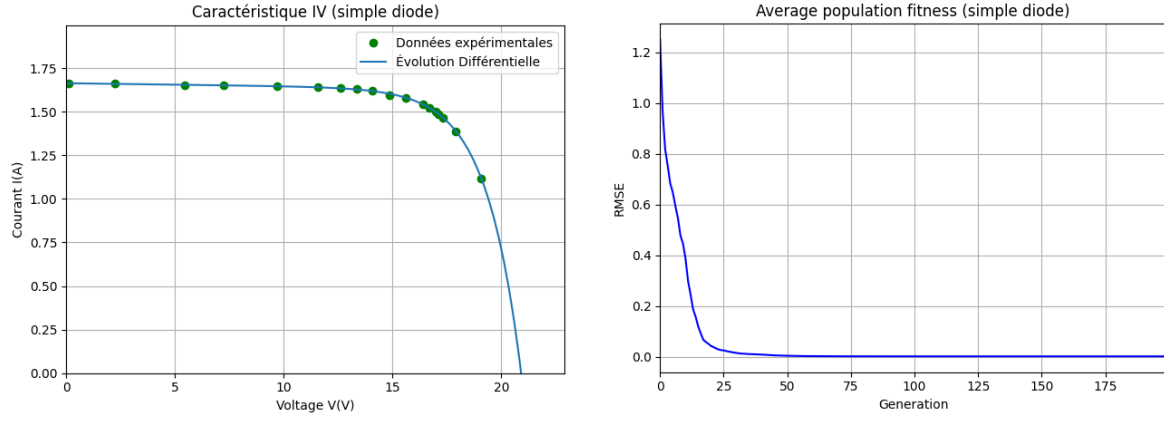
(a) Comparaison entre la courbe expérimentale et la caractéristique calculée. (b) Évolution de la valeur moyenne de fitness de chaque génération

FIGURE 4.2 – Résultats de l'ED appliquée sur la cellule RTC France 57 mm.

TABLEAU 4.2 – Comparaison de l'ED avec d'autres méthodes dans la littérature

Paramètres	Référence	R_s (Ω)	R_{sh} (Ω)	a	I_0 (μA)	I_{PV} (A)	RMSE
ED (simple diode)		0.0363	54.1134	1.4709	0.3209	0.7607	7.7692×10^{-4}
ED3P	[38]	0.0363	54.1924	1.4798	0.3191	0.7607	8.1291×10^{-4}
PSO	[48]	0.0363	53.8550	1.4816	0.3245	0.7607	9.8606×10^{-4}
ABC	[49]	0.0364	53.6433	1.4817	0.3251	0.7608	9.8620×10^{-4}
Newton	[20]	0.0364	53.7634	1.4837	0.3223	0.7608	9.70×10^{-3}
GA	[49]	0.0299	42.3729	1.5751	0.8087	0.7619	1.90×10^{-2}

En ce qui concerne le modèle double diode, les deux facteurs d'idéalité a_1 et a_2 ainsi que les courants de saturation I_{01} et I_{02} sont indépendants les uns les autres mais sont contraints dans les limites dans le tableau 4.3. Les résultats de l'ED en double diode sont comparés avec ceux de quelques autres méthode dans le tableau 4.4.



(a) Correspondence de l'ED aux données expérimentales. La distribution non-optimale des points n'entrave pas la convergence. (b) Évolution de la valeur moyenne de fitness de chaque génération. L'ED est convergente dès la 50^{ème} itération.

FIGURE 4.3 – Résultats de l'ED appliquée sur au module Schutten Solar STM6-40/36

TABLEAU 4.3 – Bornes de l'espace de recherche à 7 dimensions

Paramètre	R_s	R_{sh}	a_1	a_2	I_{01}	I_{02}	I_{PV}
Borne supérieure	1	100	2	2	1×10^{-4}	1×10^{-4}	10
Borne inférieure	0	2	1	1	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0

TABLEAU 4.4 – Comparaison de l'ED avec d'autres méthodes dans la littérature

Paramètres	Référence	R_s (Ω)	R_{sh} (Ω)	a_1	a_2	I_{01} (A)	I_{02} (A)	I_{PV} (A)	RMSE
ED (double diode)		0.02061	51.9345	1.87579	1.43602	4.2322×10^{-7}	1.8726×10^{-7}	0.76055	7.63×10^{-4}
ABC	[49]	0.0364	53.7804	1.4495	1.4885	4.07×10^{-8}	2.874×10^{-7}	0.7608	9.861×10^{-4}
PSO	[50]	0.05861	18.2106	1.00012	1.00091	2.8601×10^{-10}	1×10^{-12}	0.7633	8.1646×10^{-3}
GSA	[51]	0.02914	51.116	1.6087	1.62889	6.60621×10^{-7}	4.55149×10^{-7}	0.76886	5.91958×10^{-3}

4.3 Cas 2 : Module monocristallin Schutten Solar STM6-40/36

Nous nous concernons dans ce deuxième cas d'étude du module monocristallin Schutten Solar STM6-40/36 composé de 36 cellules ($156\text{mm} \times 156\text{mm}$) en série. Les données expérimentales ont été prises à une température de 51°C . Une comparaison des résultats de l'ED avec d'autres méthodes est présentée dans le tableau 4.5. La correspondance de la caractéristique calculée par l'ED aux points expérimentaux est démontrée graphiquement dans la figure 4.3. Malgré la distribution irrégulière des points, l'ED arrive à produire une solution précise. Sa précision est de même ordre de grandeur que ED3P [38] mais elle est supérieure aux techniques des colonies des abeilles artificielles (ABC) [49], de sa version améliorée par Oliva et al. (CIABC) [52] et Chaotic Whale Optimization Algorithm (CWOA) [53].

TABLEAU 4.5 – Comparaison de l'ED (simple diode) avec d'autres méthodes dans la littérature sur le module STM6-40/36

Paramètres	Référence	R_s (m Ω)	R_{sh} (Ω)	a	I_0 (μ A)	I_{PV} (A)	RMSE
ED (simple diode)		0.2801	16.5854	1.5571	2.8049	1.6633	1.7721×10^{-3}
ED3P	[38]	0.4186	16.7328	1.5656	2.7698	1.6632	1.7740×10^{-3}
ABC	[49]	4.99	15.206	1.4866	1.5	1.6644	1.838×10^{-3}
CIABC	[52]	4.4	15.617	1.4976	1.6642	1.6760	1.819×10^{-3}
CWOA	[53]	5	15.4	1.5	1.6338	1.7	1.800×10^{-3}

Les résultats de l'ED avec le modèle double diode sur le module STM6-40/36 sont présenté dans le tableau 4.6 avec d'autres techniques tel quel les colonies d'abeilles artificielles et les essais particuliers. Le tableau 4.7 montre les bornes utilisées comme limites de l'espace de recherche. Notons la similarité des qualités des résultats du modèle simple et double diode.

TABLEAU 4.6 – Comparaison de l'ED (double diode) avec d'autres méthodes sur le module photovoltaïque STM6-40/36

Paramètres	Référence	R_s (Ω)	R_{sh} (Ω)	a_1	a_2	I_{01} (A)	I_{02} (A)	I_{PV} (A)	RMSE
ED (double diode)		0.0177	16.7050	1.9049	1.52461	1.006×10^{-6}	2.9858×10^{-6}	1.6633	1.7724×10^{-3}
ELPSO	[54]	0.0138	16.8580	1.8706	1.16648	1.670×10^{-8}	6.21092×10^{-6}	1.6648	1.8307×10^{-3}
ABC	[54]	0.03434	26.0613	1.9851	1.4687**	8.938×10^{-6}	1×10^{-12}	1.66347	2.0538×10^{-3}

TABLEAU 4.7 – Limites de l'espace de recherche pour l'ED double diode sur le module photovoltaïque STM6-40/36

Paramètre	R_s	R_{sh}	a_1	a_2	I_{01}	I_{02}	I_{PV}
Borne Supérieure	1	100	2	2	1×10^{-4}	1×10^{-4}	10
Borne inférieure	0	2	1	1	0	0	0

4.4 Cas 3 : Module polycristallin Photowatt-PWP 201

Le 3^{ème} cas concerne le module polycristallin Photowatt-PWP 201 composé de 36 cellules en série. Les données expérimentales ont été prise dans des conditions d'irradiation de 1000 W m^{-2} et une température de $T = 45^\circ\text{C}$. Le tableau 4.8 compare les résultats obtenus par Évolution Différentielle contre d'autres méthodes dans la littérature. Les valeurs des paramètres simple diode retrouvée par l'ED sont très similaires aux autres, mais sont plus précises en termes de RMSE. Figure 4.4 montre la courbe caractéristique calculée (a) et la courbe de convergence de l'ED (b). Les bornes de l'espace de recherche sont identiques à celle de la cellule RTC France (Tableau 4.1) sauf pour le courant de saturation qu'on limite à $1 \times 10^{-7} \leq I_0 \leq 1 \times 10^{-5}$. Le modèle double diode est plus précis que le modèle simple diode avec l'ED, mais ce dernier reste plus précis que les autres techniques similaires.

TABLEAU 4.8 – Comparaison de l'ED avec d'autres méthodes dans la littérature sur le module Photowatt-PWP 201

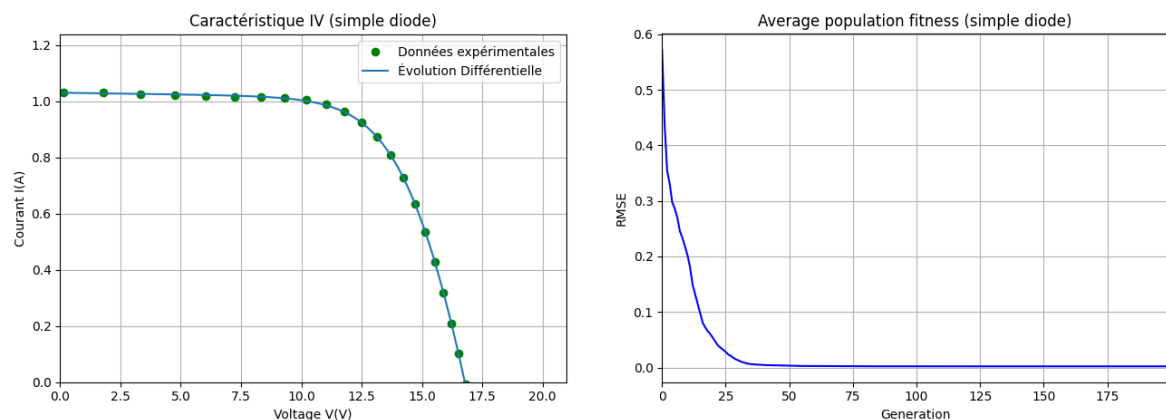
Paramètres	Référence	R_s (m Ω)	R_{sh} (Ω)	a	I_0 (μ A)	I_{PV} (A)	RMSE
ED (simple diode)		0.0343	22.8238	1.3139	2.6380	1.0314	2.0529×10^{-3}
ED3P	[38]	0.0347	19.3720	1.3002	2.1247	1.0335	2.4227×10^{-3}
ISCE	[55]	0.0333	27.2772	1.3512	3.4823	1.0305	2.4251×10^{-3}
CIABC	[56]	0.0333	27.2772	1.3512	3.4822	1.0305	2.425×10^{-3}
Newton	[20]	0.0335	15.2625	1.3458	3.2876	1.0318	5.6010×10^{-1}

TABLEAU 4.9 – Comparaison de l'ED avec d'autres méthodes sur le module photovoltaïque Photowatt-PWP 201

Paramètres	Référence	R_s (Ω)	R_{sh} (Ω)	a_1	a_2	I_{01} (A)	I_{02} (A)	I_{PV} (A)	RMSE
ED (double diode)		0.8604	19.2098	1.2165	1.5326	1.6785×10^{-7}	2.6073×10^{-6}	1.03193	1.50208×10^{-3}
TVACPSO	[50]	1.2356	22.8236	1.3210	2.7778	2.6381×10^{-6}	1×10^{-12}	1.03143	2.0530×10^{-3}

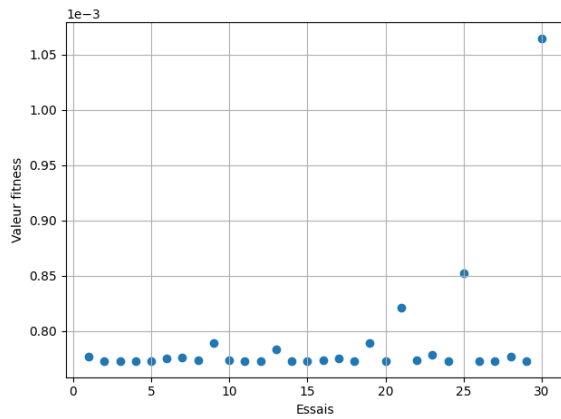
4.5 Analyse et cohérence de l'ED

La performance supérieure démontrée par l'ED par rapport aux autres algorithmes provient probablement de ses capacités à la *recherche globale*. L'existence d'une multitude de minimums locaux est démontrée dans la figure 4.5 où on a projeté l'espace de recherche 5-dimensionnel sur 2 dimensions au voisinage du minimum global. On fait varier le facteur d'idéalité a et la résistance série R_s dont le modèle est très sensible aux variations. Les trois autres paramètres R_{sh} , I_0 et I_{PV} sont fixés sur les valeurs du minimum global retrouvé par l'ED comme dans le tableau 4.2.

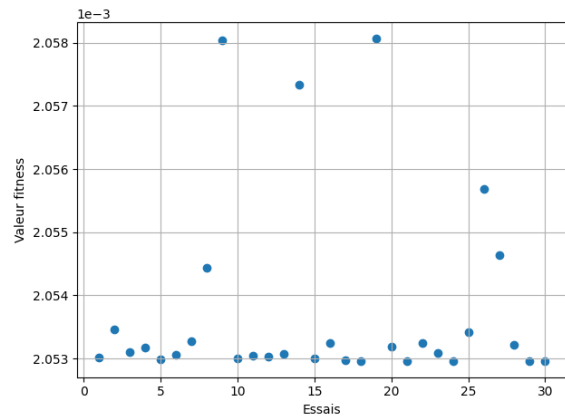


(a) Caractéristique expérimentale et calculée du module polycristallin Photowatt-PWP 201. (b) Courbe de convergence de L'ED. Notons la convergence rapide (avant < 100 itérations)

FIGURE 4.4 – Résultats de l'ED appliquée sur au module Photowatt PWP-201



(a) Cellule RTC France 57 mm



(b) Module Photowatt-PWP 201

FIGURE 4.6 – Les RMSEs obtenues lors de 30 essais indépendants

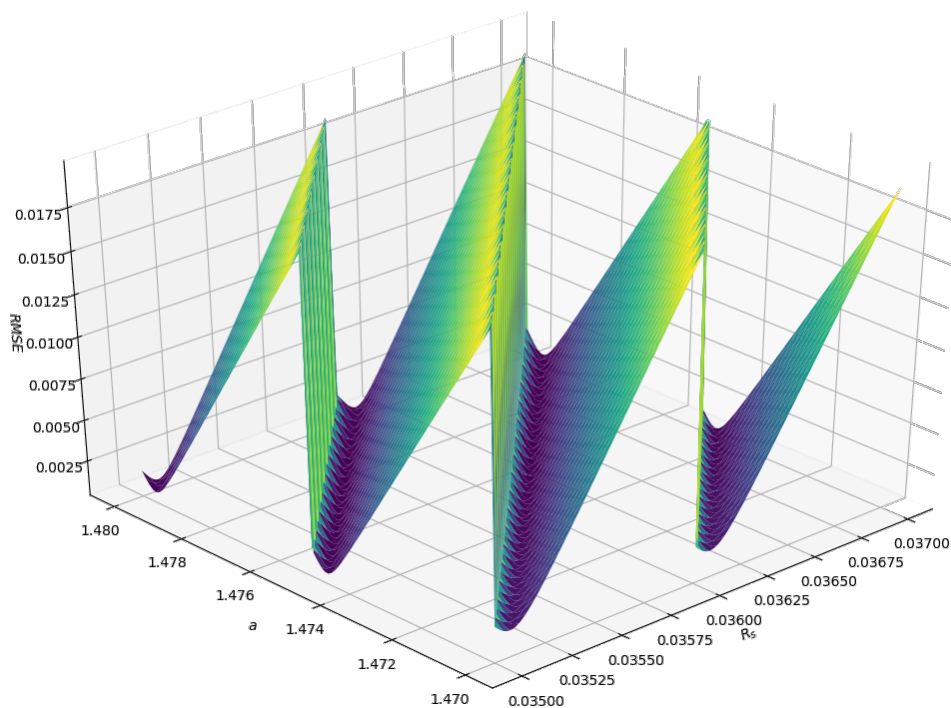


FIGURE 4.5 – Le voisinage du minimum global retrouvé par l'ED selon le facteur d'idéalité et la résistance en série. Notons l'existence des "vallées" qui comprennent potentiellement plusieurs minimums locaux

La nature stochastique de l'Évolution Différentielle fait qu'elle donne des résultats différents après chaque essai. Ceci impose une analyse de cohérence de la méthode pour estimer la fiabilité de l'ED pendant plusieurs essais consécutifs. Figure 4.6 montre la RMSE de la solution finale dans 30 essais indépendants de l'ED. Tous les points sont localisés dans une région très concentrée de l'espace de recherche ce qui indique que l'ED parvient effectivement à localiser le minimum global. La cohérence des différents essais concernant la R_s et le a du module Photowatt-PWP 201 (Figure 4.7) et les écart-types des paramètres montrés sur le tableau 4.10 confirment ceci puisque ils peuvent être interprétés comme un indice de "stabilité" de l'algorithme qui quantifié sa capacité à reproduire les mêmes résultats. Tous les écart-types sont de l'ordre de 10^{-3} ou moins, donc une solution précise est garantie dans n'importe quel essai.

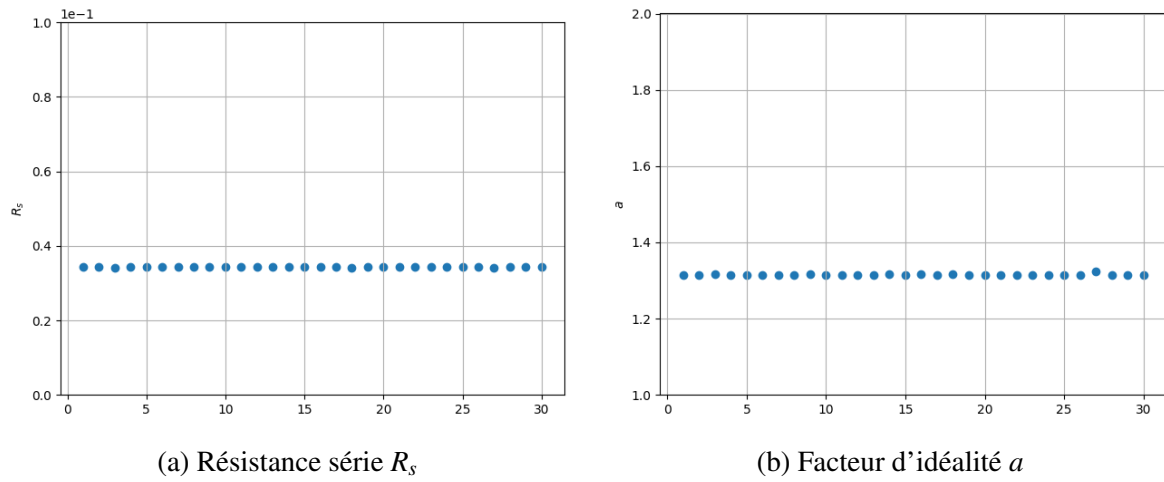


FIGURE 4.7 – Résultats obtenus pour le facteur d'idéalité et la résistance série du module PHotowatt-PWP 201 pendant 30 essais indépendants

TABLEAU 4.10 – Valeurs Moyennes de quelques paramètres influents de la cellule RTC France 57 mm et les écart-types associés des 30 essais

Paramètre	Valeur Moyenne	Écart-Type
$RMSE$	7.8925×10^{-4}	5.3670×10^{-5}
R_s	3.6355×10^{-2}	3.8936×10^{-4}
a	1.4722	5.7539×10^{-3}
I_0	3.2655×10^{-7}	3.4071×10^{-8}

4.6 Conclusion

Le modèle double diode contient deux termes exponentiels nécessitant deux évaluations de la fonction W de Lambert pour chaque point expérimental, ce qui est relativement coûteux d'un point de vue de calcul numérique. Par ailleurs, puisque tous les paramètres sont traités indépendamment des autres, l'espace de recherche est effectivement à 7 dimensions. Puisque la qualité des résultats des modèles simple et double diode est quasi-identique dans le cas de la cellule RTC France (Tableaux 4.2 et 4.4 respectivement) ainsi que pour le module photovoltaïque monocristallin Schutten Solar STM6-40/36 (Tableaux 4.5 et 4.6), on constate que le modèle simple diode est très adéquat en terme de précision et supérieur en terme d'efficacité et rapidité de calcul.

Bibliographie

- [1] D. M. Chapin, C. S. Fuller, and G. L. Pearson, "A new silicon p-n junction photocell for converting solar radiation into electrical power [3]," 1954.
- [2] "Renewable Energy Market Update," tech. rep., IEA, 2020.
- [3] L. Fraas and L. Partain, *Solar Cells and their Applications : Second Edition*. 2010.
- [4] S. M. Sze, *Semiconductor Devices : Physics and Technology*. 2006.
- [5] S. R. Wenham, M. A. Green, M. E. Watt, R. P. Corkish, and A. B. Sproul, *Applied photovoltaics, third edition*. 2013.
- [6] W. Shockley and H. J. Queisser, "Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells," *Journal of Applied Physics*, 1961.
- [7] J. P. Ram, H. Manghani, D. S. Pillai, T. S. Babu, M. Miyatake, and N. Rajasekar, "Analysis on solar PV emulators : A review," 2018.
- [8] K. L. Kennerud, "Analysis of Performance Degradation in CDS Solar Cells," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 1969.
- [9] W. J. Jamil, H. Abdul Rahman, S. Shaari, and Z. Salam, "Performance degradation of photovoltaic power system : Review on mitigation methods," 2017.
- [10] P. K. Nayak, S. Mahesh, H. J. Snaith, and D. Cahen, "Photovoltaic solar cell technologies : analysing the state of the art," *Nature Reviews Materials*, 2019.
- [11] K. L. Chopra, P. D. Paulson, and V. Dutta, "Thin-film solar cells : an overview," *Progress in Photovoltaics : Research and Applications*, 2004.
- [12] C. Roger, *Developpement de cellules photovoltaïques à base de CIGS sur substrats métalliques*. PhD thesis, Université de Grenoble, 2013.
- [13] H. Huang, "Ferroelectric photovoltaics," *Nature photonics* 4, pp. 134–135, 2010.
- [14] M. G. Villalva, J. R. Gazoli, and E. R. Filho, "Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays," *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2009.
- [15] V. J. Chin, Z. Salam, and K. Ishaque, "Cell modelling and model parameters estimation techniques for photovoltaic simulator application : A review," 2015.
- [16] C. Carrero, J. Amador, and S. Arnaltes, "A single procedure for helping PV designers to select silicon PV modules and evaluate the loss resistances," *Renewable Energy*, 2007.
- [17] H.-L. Tsai, C.-S. Tu, and Y.-J. Su, "Development of Generalized Photovoltaic Model Using MATLAB/SIMULINK," *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, vol. 2173, no. 1, pp. 846–851, 2008.
- [18] W. Shockley, "The Theory of p-n Junctions in Semiconductors and p-n Junction Transistors," *Bell System Technical Journal*, 1949.
- [19] G. Ciulla, V. Lo Brano, V. Di Dio, and G. Cipriani, "A comparison of different one-diode models for the representation of I-V characteristic of a PV cell," 2014.
- [20] T. Easwarakhanthan, J. Bottin, I. Bouhouch, and C. Boutrit, "Nonlinear Minimization Algorithm for Determining the Solar Cell Parameters with Microcomputers," *International Journal of Solar Energy*, 1986.

- [21] K. M. El-Naggar, M. R. AlRashidi, M. F. AlHajri, and A. K. Al-Othman, "Simulated Annealing algorithm for photovoltaic parameters identification," *Solar Energy*, 2012.
- [22] W. T. Da Costa, J. F. Fardin, D. S. Simonetti, and L. D. V. Neto, "Identification of photovoltaic model parameters by differential evolution," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology*, 2010.
- [23] M. Balzani and A. Reatti, "Neural network based model of a PV array for the optimum performance of PV system," in *2005 PhD Research in Microelectronics and Electronics - Proceedings of the Conference*, 2005.
- [24] L. Zhang and Y. F. Bai, "Genetic algorithm-trained radial basis function neural networks for modelling photovoltaic panels," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2005.
- [25] E. Karatepe, M. Boztepe, and M. Colak, "Neural network based solar cell model," *Energy Conversion and Management*, 2006.
- [26] M. T. Elhagry, A. A. Elkousy, M. B. Saleh, T. F. Elshatter, and E. M. Abou-Elzahab, "Fuzzy modeling of photovoltaic panel equivalent circuit," in *Midwest Symposium on Circuits and Systems*, 1997.
- [27] T. Bendib, F. Djeflal, D. Arar, and M. Meguellati, "Fuzzy-logic-based approach for organic solar cell parameters extraction," in *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, 2013.
- [28] M. AbdulHadi, A. M. Al-Ibrahim, and G. S. Virk, "Neuro-fuzzy-based solar cell model," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2004.
- [29] J. A. Jervase, H. Bourdouden, and A. Al-Lawati, "Solar cell parameter extraction using genetic algorithms," *Measurement Science and Technology*, 2001.
- [30] N. Moldovan, R. Picos, and E. Garcia-Moreno, "Parameter extraction of a solar cell compact model using genetic algorithms," in *Proceedings of the 2009 Spanish Conference on Electron Devices, CDE'09*, 2009.
- [31] M. S. Ismail, M. Moghavvemi, and T. M. Mahlia, "Characterization of PV panel and global optimization of its model parameters using genetic algorithm," *Energy Conversion and Management*, 2013.
- [32] M. Ye, X. Wang, and Y. Xu, "Parameter extraction of solar cells using particle swarm optimization," *Journal of Applied Physics*, 2009.
- [33] J. J. Soon and K. S. Low, "Photovoltaic model identification using particle swarm optimization with inverse barrier constraint," *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2012.
- [34] K. Ishaque, Z. Salam, S. Mekhilef, and A. Shamsudin, "Parameter extraction of solar photovoltaic modules using penalty-based differential evolution," *Applied Energy*, 2012.
- [35] W. Gong and Z. Cai, "Parameter extraction of solar cell models using repaired adaptive differential evolution," *Solar Energy*, 2013.
- [36] T. Ikegami, T. Maezono, F. Nakanishi, Y. Yamagata, and K. Ebihara, "Estimation of equivalent circuit parameters of PV module and its application to optimal operation of PV system," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 2001.
- [37] R. Storn and K. Price, "Differential evolution - A simple and efficient adaptive scheme for global optimization over continuous spaces," tech. rep., 1995.
- [38] V. J. Chin and Z. Salam, "A New Three-point-based Approach for the Parameter Extraction of Photovoltaic Cells," *Applied Energy*, 2019.
- [39] K. Price, R. M. Storn, and J. A. Lampinen, *Differential evolution : a practical approach to global optimization*. Springer Science & Business Media, 2005.
- [40] M. Shur, T. A. Fjeldly, and B. J. Moon, "Approximate Analytical Solution of Generalized Diode Equation," *IEEE Transactions on Electron Devices*, 1991.

- [41] M. T. Abuelma'Atti, "Improved approximate analytical solution for generalised diode equation," *Electronics Letters*, 1992.
- [42] S. K. Datta, K. Mukhopadhyay, S. Bandopadhyay, and H. Saha, "An improved technique for the determination of solar cell parameters," *Solid State Electronics*, 1992.
- [43] A. Jain and A. Kapoor, "Exact analytical solutions of the parameters of real solar cells using Lambert W-function," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 2004.
- [44] S. xian Lun, S. Wang, G. hong Yang, and T. ting Guo, "A new explicit double-diode modeling method based on Lambert W-function for photovoltaic arrays," *Solar Energy*, 2015.
- [45] R. M. Corless, G. H. Gonnet, D. E. Hare, D. J. Jeffrey, and D. E. Knuth, "On the Lambert W function," *Advances in Computational Mathematics*, 1996.
- [46] D. Zaharie, "Critical values for the control parameters of differential evolution algorithms," in *MENDEL 2002, 8th Int. Conf. on Soft Computing*, pp. 62–67, 2002.
- [47] R. Salomon, "Re-evaluating genetic algorithm performance under coordinate rotation of benchmark functions. A survey of some theoretical and practical aspects of genetic algorithms," *Bio-Systems*, 1996.
- [48] N. F. A. Hamid, N. A. Rahim, and J. Selvaraj, "Solar cell parameters identification using hybrid Nelder-Mead and modified particle swarm optimization," *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, 2016.
- [49] D. Oliva, E. Cuevas, and G. Pajares, "Parameter identification of solar cells using artificial bee colony optimization," *Energy*, 2014.
- [50] A. R. Jordehi, "Time varying acceleration coefficients particle swarm optimisation (TVACPSO) : A new optimisation algorithm for estimating parameters of PV cells and modules," *Energy Conversion and Management*, 2016.
- [51] A. R. Jordehi, "Gravitational search algorithm with linearly decreasing gravitational constant for parameter estimation of photovoltaic cells," in *2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2017 - Proceedings*, 2017.
- [52] D. Oliva, A. A. Ewees, M. A. El Aziz, A. E. Hassanien, and M. P. Cisneros, "A chaotic improved artificial bee colony for parameter estimation of photovoltaic cells," *Energies*, 2017.
- [53] D. Oliva, M. Abd El Aziz, and A. Ella Hassanien, "Parameter estimation of photovoltaic cells using an improved chaotic whale optimization algorithm," *Applied Energy*, 2017.
- [54] A. Rezaee Jordehi, "Enhanced leader particle swarm optimisation (ELPSO) : An efficient algorithm for parameter estimation of photovoltaic (PV) cells and modules," *Solar Energy*, 2018.
- [55] X. Gao, Y. Cui, J. Hu, G. Xu, Z. Wang, J. Qu, and H. Wang, "Parameter extraction of solar cell models using improved shuffled complex evolution algorithm," *Energy Conversion and Management*, 2018.
- [56] L. Wu, Z. Chen, C. Long, S. Cheng, P. Lin, Y. Chen, and H. Chen, "Parameter extraction of photovoltaic models from measured I-V characteristics curves using a hybrid trust-region reflective algorithm," *Applied Energy*, 2018.